

NEC

保守/廃止

MOS 形電界効果パワー トランジスタ  
MOS Field Effect Power Transistor  
**2SK872**

## N チャンネルパワー MOS FET

スイッチング用

工業用

2SK872 は、N チャンネルエンハンスメント形パワー MOS FET でオン抵抗が低く、スイッチング特性が優れており、高周波スイッチング電源、DC-DC コンバータに最適です。

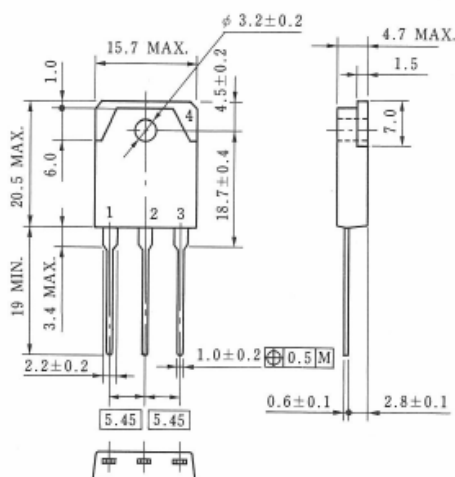
## 特 徴

- $V_{DSS} = 900 \text{ V}$ ,  $I_{D(DC)} = \pm 6 \text{ A}$
- 低オン抵抗  $R_{DS(on)} \leq 2.5 \Omega$
- 高速スイッチングです。  
 $t_{on} = 50 \text{ ns TYP.}$   $t_{off} = 200 \text{ ns TYP.}$
- 安全動作領域が広い。

絶対最大定格 ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

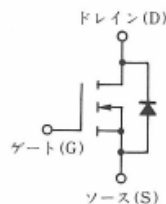
項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0$	900	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$V_{DS} = 0$	$\pm 20$	V
ドレイン電流(直 流)	$I_{D(DC)}$		$\pm 6$	A
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(pulse)}$	$PW \leq 100 \mu\text{s}$ $Duty \text{ Cycle} \leq 2 \%$	$\pm 12$	A
全 損 失	$P_T$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
チャネル温度	$T_{ch}$		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$		$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

外形図 (単位: mm)



電極接続

1. Gate
2. Drain
3. Source
4. Fin(Drain)



(上図中のダイオードは寄生ダイオードです。)